

2SA603

# 2SA603

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ / PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅, 中速度スイッチング用 /

High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching

通信工業用 / Industrial Use

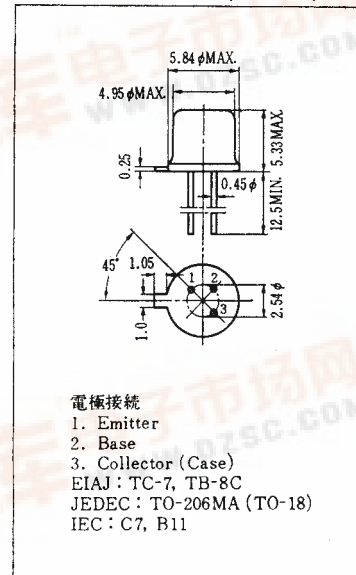
### 特 徴 / FEATURES

- ・電源電圧の変動に対して余裕があります。V<sub>CEO</sub>: -40V  
Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
- ・従来の拡散形トランジスタに比べてベース逆バイアスを深くかけることができます。  
V<sub>EBO</sub>: -8.0V  
Available for deeper base reverse bias than with normal diffused transistor.
- ・高周波増幅はもとよりスイッチング, 低周波増幅などの用途にも適します。  
Suitable for switching and audio amplifiers as well as high frequency amplifiers.

### 絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>a</sub> = 25°C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CBO</sub>	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	-8.0	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	-200	mA
全損失	P <sub>T</sub>	300	mW
ジャンクション温度	T <sub>j</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150	°C

### 外形図 / PACKAGE DIMENSIONS (Unit:mm)



### 電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>a</sub> = 25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタしゃ断電流	I <sub>CBO</sub>	V <sub>CE</sub> = -40V, I <sub>E</sub> = 0			-0.5	μA
エミッタしゃ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -5.0V, I <sub>C</sub> = 0			-0.5	μA
直流電流増幅率	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> = -1.0V, I <sub>C</sub> = -10mA	80	140	240	
直流電流増幅率	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> = -1.0V, I <sub>C</sub> = -100mA	30	70		
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -100mA, I <sub>B</sub> = -10mA		-0.25	-0.7	V
ベース飽和電圧	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -100mA, I <sub>B</sub> = -10mA		-0.85	-1.20	V
利得帯域幅積	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 10mA	150	250		MHz
コレクタ容量	C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 0, f = 1.0MHz		7.5	10	pF
ターンオン時間	t <sub>on</sub>			150		ns
蓄積時間	t <sub>stg</sub>	測定回路図参照/See test circuit		240		ns
ターンオフ時間	t <sub>off</sub>			300		ns

h<sub>FE</sub> 区分 / h<sub>FE</sub> Classification

h<sub>FE1</sub> / 80~130    110~170    150~240

